


	<p>SIR484DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR484DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 20A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR484DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 41591 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




Spezifikationen

Teilenummer	SIR484DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 20A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	41591 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.3 mOhm @ 17.2A, 10V
Verlustleistung (max)	3.9W (Ta), 29.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR484DP-T1-GE3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	830pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 20A (Tc) 3.9W (Ta), 29.8W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

SIR484DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR484DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR484DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIR484DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR484DP-T1-E3 VISHAY SIR484DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR482DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR482DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR494 EVERLIG EVERLIG DIP-2</p>
 <p>SIR484DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR492DP SI SIR492DP SI</p>	 <p>SIR492DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR492DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 40A PPAK SO-8</p>

SIR484DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SIR484DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR484DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR484DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR484DP-T1-GE3
SIR484DP-T1-GE3 Electronic	SIR484DP-T1-GE3-Komponenten	SIR484DP-T1-GE3-Verteiler	SIR484DP-T1-GE3-Bild	SIR484DP-T1-GE3-Teil
SIR484DP-T1-GE3 Preis	SIR484DP-T1-GE3 Hersteller	SIR484DP-T1-GE3 Bild	SIR484DP-T1-GE3 Aktie	SIR484DP-T1-GE3 Inventar
SIR484DP-T1-GE3 Neu	SIR484DP-T1-GE3 Original	SIR484DP-T1-GE3 garantiert	SIR484DP-T1-GE3 RFQ	SIR484DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited